

关键指标

频率：33~37GHz
增益：25dB
噪声系数：1.9dB
1dB 压缩点输出功率：11dBm
电压/电流：+5V/18mA
芯片尺寸：1.4mm×0.85mm×0.1mm

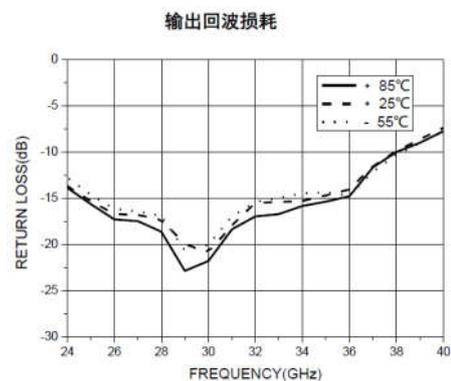
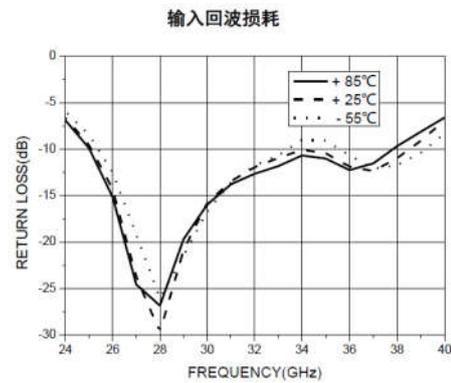
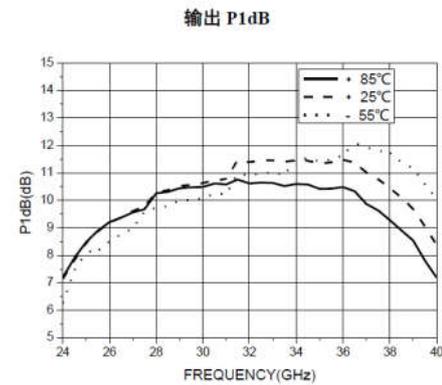
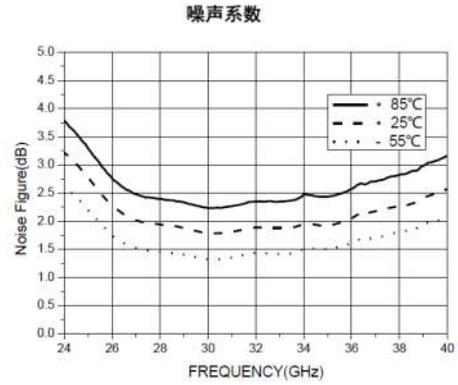
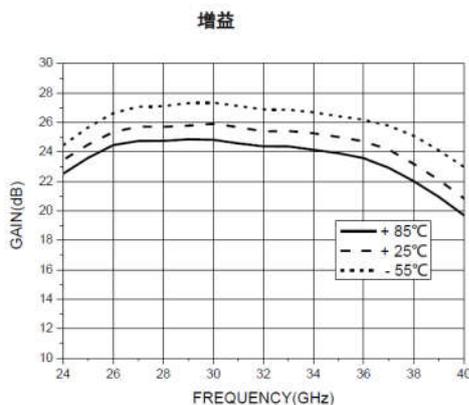
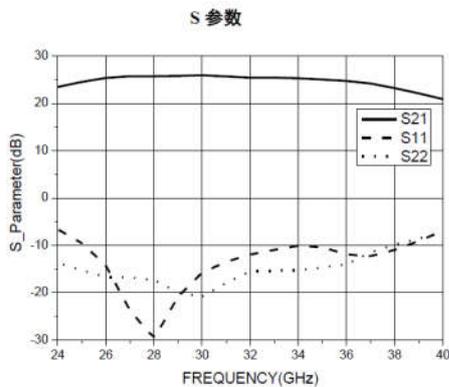
产品简介

HG118F2 是一款 33~37GHz 低噪声放大器芯片，增益为 25dB，噪声系数为 1.9dB，1dB 压缩点输出功率为 11dBm。

电性能 (T_A=25°C, V_{dd}=+5V)

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	33~37		
增益(dB)	—	25	—
噪声系数(dB)	—	1.9	—
输入回波损耗	—	11	—
输出回波损耗	—	14	—
1dB 压缩点输出功率(dBm)	—	11	—
静态电流 (mA)	—	18	—

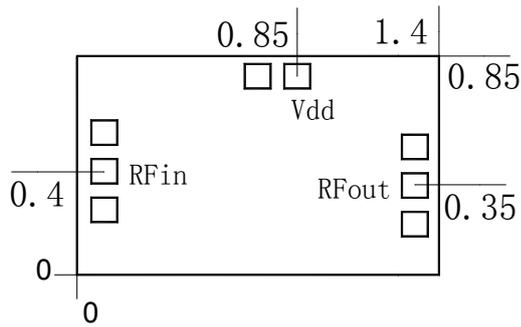
典型测试曲线



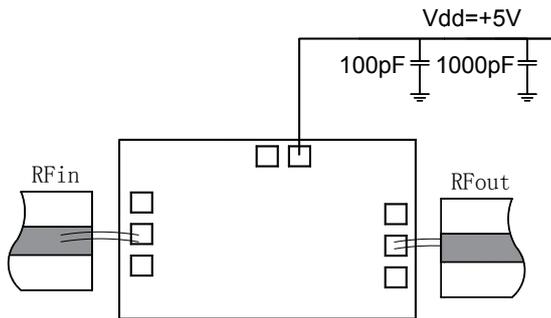
绝对额定最大值

工作电压	+4V
射频输入功率	+3dBm
工作温度	-55°C ~ 125°C
存储温度	-65°C ~ 150°C

外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm ；
5. 芯片微波输入端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。